

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年10月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-311820

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-311820 ]

出 願 人

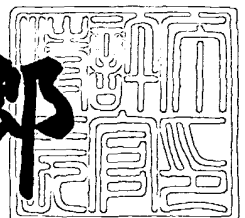
Applicant(s):

京セラ株式会社

2003年 5月20日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3036933

【書類名】 特許願

【整理番号】 27595

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/304

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県八日市市蛇溝町長谷野 1 1 6 6 番地の 6 京セラ  
株式会社滋賀八日市工場内

【氏名】 猪股 洋介

【特許出願人】

【識別番号】 000006633

【住所又は居所】 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

【氏名又は名称】 京セラ株式会社

【代表者】 西口 泰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005337

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 エッチング装置およびエッチング方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、棒状部材によって構成される略平板状の障害物を設置したことを特徴とするエッチング装置。

【請求項 2】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、メッシュ構造の略平板状の障害物を設置したことを特徴とするエッチング装置。

【請求項 3】 前記障害物はその構成部材単体もしくは複数の組み合わせにより開口部が形成されることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のエッチング装置。

【請求項 4】 前記障害物が複数の積層構造であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のエッチング装置。

【請求項 5】 前記障害物の開口率が 5 ～ 4 0 % であることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のエッチング装置。

【請求項 6】 前記障害物のうち少なくとも 1 層がガラス系材料または金属材料から構成されていることを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載のエッチング装置。

【請求項 7】 前記障害物のうち少なくとも 1 層がアルミニウム系の材料から構成されていることを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載のエッチング装置。

【請求項 8】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、シート部材からなる障害物を載置したことを特徴とするエッチング装置。

【請求項 9】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、

この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、棒状部材によって構成される略平板状の障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とするエッチング方法。

【請求項 1 0】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、メッシュ構造の略平板状の略平板状の障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とするエッチング方法。

【請求項 1 1】 陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、シート部材からなる障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とするエッチング方法。

【請求項 1 2】 前記基板がシリコン、ガラス、金属、プラスチック、または樹脂のいずれかから成ることを特徴とする請求項 9 ないし 1 1 のいずれかに記載のエッチング方法。

【請求項 1 3】 前記障害物と前記基板との距離を 5 ～ 3 0 m m 離して設置することを特徴とする請求項 9 ないし 1 1 のいずれかに記載のエッチング方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明はエッチング装置とエッチング方法に関し、特に太陽電池などに用いられるシリコン基板等に微細な凹凸を高タクトに形成することができるエッチング装置とエッチング方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】

太陽電池は表面に入射した太陽光などの光エネルギーを電気エネルギーに変換するものである。この電気エネルギーへの変換効率を向上させるため、従来から

様々な試みがなされてきた。そのひとつに基板の表面に入射した光の反射を少なくする技術があり、入射した光の反射を低減することで電気エネルギーへの変換効率を高めることができる。

## 【 0 0 0 3 】

太陽電池は、材料によって結晶系、アモルファス系、化合物系などに分類される。このうち、現在市場で流通しているのはほとんどが結晶系シリコン太陽電池である。この結晶系シリコン太陽電池はさらに単結晶型、多結晶型に分類される。単結晶型シリコン太陽電池は基板の品質がよいため、高効率化が容易であるという長所を有する反面、基板の製造コストが大きいという短所を有する。それに対し、多結晶型シリコン太陽電池は基板の品質が劣るために高効率化が難しいという欠点はあるものの、低コストで製造できるというメリットがある。また、最近では多結晶シリコン基板の品質の向上やセル化技術の進歩により、研究レベルでは 1 8 % 程度の変換効率が達成されている。

## 【 0 0 0 4 】

一方、量産レベルの多結晶シリコン太陽電池は低コストであったため、従来から市場に流通してきたが、近年環境問題が取りざたされる中でさらに需要が増してきており、低コストで且つより高い変換効率が求められるようになった。

## 【 0 0 0 5 】

シリコン基板を用いて太陽電池素子を形成する場合に、基板の表面を水酸化ナトリウムなどのアルカリ水溶液でエッチングすると、表面に微細な凹凸が形成されて基板表面での反射をある程度低減させることができる。

## 【 0 0 0 6 】

面方位が ( 1 0 0 ) 面の単結晶シリコン基板を用いた場合は、このような方法でテクスチャー構造と呼ばれるピラミッド構造を基板の表面に均一に形成することができるものの、アルカリ水溶液によるエッチングは結晶の面方位に依存することから、多結晶シリコン基板で太陽電池素子を形成する場合、ピラミッド構造を均一には形成できず、そのため全体の反射率も効果的には低減できないという問題がある。

## 【 0 0 0 7 】

このような問題を解決するために、太陽電池素子を多結晶シリコン基板で形成する場合に、基板表面に微細な突起を反応性イオンエッチング (Reactive Ion Etching) 法で形成することが提案されている (例えば特許文献 1 参照)。すなわち、多結晶シリコンにおける不規則な結晶の面方位に左右されずに微細な突起を均一に形成し、特に多結晶シリコンを用いた太陽電池素子においても、反射率をより効果的に低減しようとするものである。

## 【 0 0 0 8 】

しかしながら、凹凸を形成するための条件は非常に微妙であり、また、装置の構造によっても変化するため、条件の検討は非常に難しいことが多い。微細な突起を均一に形成できない場合は、太陽電池の光電変換効率が低下し、個々の太陽電池の価値はその発電効率で決まることから、そのコストを低減するためには、太陽電池の変換効率を向上させなければならない。

## 【 0 0 0 9 】

また、反応性イオンエッチング法で用いられる反応性イオンエッチング装置は一般に平行平板電極型をしており、基板を設置している電極の側に R F 電圧を印加し、他の一方の側及び内部の側壁をアースに接続してある。この容器内部を真空ポンプで真空引きし、真空引き完了後、エッチングガスを導入し、圧力を一定に保持しながら内部の被エッチング基板をエッチングする。エッチングが完了した後に、容器内部を大気圧に戻す。

## 【 0 0 1 0 】

このような手順を踏むことから、反応性イオンエッチング装置では真空引き及び大気リークの待ち時間が多い。また、反応性イオンエッチング装置は L S I などの精密な小型半導体素子に用いられる場合が多いが、太陽電池用基板のエッチングに用いる際には太陽電池自身の面積が大きいため、1 回あたりの処理枚数が少なく、コストが高くなるという問題があった。そのため反応性イオンエッチング装置を太陽電池の製造工程に用いる場合には、いかに高タクトで処理を行うかも重要なポイントである。

## 【 0 0 1 1 】

本発明はこのような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、基板、特

に太陽電池に用いられるシリコン基板等の基板表面に凹凸を効率よく均一に形成する方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 2 】

【特許文献 1】

特公昭 6 0 - 2 7 1 9 5 号公報

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項 1 に係る基板のエッチング装置では、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、棒状部材によって構成される略平板状の障害物を設置したことを特徴とする。

【 0 0 1 4 】

また請求項 2 に係るエッチング装置では、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、メッシュ構造の略平板状の障害物を設置したことを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

前記障害物は、例えばその構成部材単体もしくは複数の組み合わせにより開口部が形成されてもよい。

【 0 0 1 6 】

前記障害物は、例えば複数の積層構造であってもよい。

【 0 0 1 7 】

前記障害物の開口率はそれぞれ 5 ～ 4 0 % であることが望ましい。

【 0 0 1 8 】

前記障害物のうち少なくとも 1 層はガラス系材料または金属材料から構成されることが望ましい。

【 0 0 1 9 】

前記障害物のうち少なくとも 1 層はアルミニウム系の材料から構成されてもよい。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 8 に係るエッチング装置によれば、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、前記基板と陽極側電極との間に、シート部材からなる障害物を載置したことを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

また、請求項 9 に係るエッチング方法によれば、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、棒状部材によって構成される略平板状の障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

また、請求項 1 0 に係るエッチング方法によれば、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、メッシュ構造の略平板状の略平板状の障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

さらに、請求項 1 1 に係るエッチング方法によれば、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面をドライエッチング法で粗面状にするエッチング方法において、前記基板と陽極側電極との間に、シート部材からなる障害物を設置して前記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることを特徴とするエッチング方法。

【 0 0 2 4 】

前記基板はシリコン、ガラス、金属、プラスチック、または樹脂のいずれかからなる。

【 0 0 2 5 】

前記障害物と前記基板との距離を 5 ～ 3 0 m m 離して設置することが望ましい。



【 0 0 2 6 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を添付図面に基づき詳細に説明する。

図 1 は本発明の方法を用いて形成される太陽電池素子を示す図であり、1 はシリコン基板、2 は表面凹凸構造、3 は受光面側の不純物拡散層、4 は裏面側の不純物拡散層（B S F）、5 は反射防止膜、6 は表面電極、7 は裏面電極である。

【 0 0 2 7 】

前記シリコン基板 1 は単結晶もしくは多結晶のシリコン基板である。この基板は p 型、n 型いずれでもよい。単結晶シリコンの場合は引き上げ法などによって形成され、多結晶シリコンの場合は鋳造法などによって形成される。多結晶シリコンは、大量生産が可能で製造コスト面で単結晶シリコンよりもきわめて有利である。引き上げ法や鋳造法によって形成されたインゴットを 3 0 0  $\mu$  m 程度の厚みにスライスして、1 5 c m  $\times$  1 5 c m 程度の大きさに切断してシリコン基板 1 となる。

【 0 0 2 8 】

シリコン基板 1 の表面側には、逆導電型半導体不純物が拡散された層 3 と反射防止膜 5 が形成されている。また、シリコン基板 1 の裏面側には、一導電型半導体不純物が高濃度に拡散された層（B S F）4 を形成することが望ましい。シリコン基板 1 の表面側および裏面側には、表面電極 6 および裏面電極 7 が形成されている。この表面電極 6 および裏面電極 7 は A g ペーストをスクリーン印刷して焼成し、その上に半田層を設けて形成する。

【 0 0 2 9 】

シリコン基板 1 の表面側には、入射する光を反射させずに有効に取り込むために微細な表面凹凸構造 2 を形成して粗面化する。これは、真空引きされたチャンバ内にガスを導入し、一定圧力に保持して、チャンバ内に設けられた電極に R F 電力を印加することでプラズマを発生させ、生じた活性種であるイオン・ラジカル等の作用により基板の表面をエッチングするものである。

【 0 0 3 0 】

反応性イオンエッチング（R I E）法と呼ばれるこの方法は図 2 および図 3 の

ように示される。図2および図3において、1はエッチングされる基板、8はマスフローコントローラ、9はRF電極（陰極側電極）、10は圧力調整器、11は真空ポンプ、12はRF電源である。装置内にマスフローコントローラ8部分からエッチングガスを導入するとともに、RF電源12でプラズマを発生させてイオンやラジカルを励起活性化して、RF電極（陰極側電極）9の上部に配設されたシリコン基板1の表面に作用させてエッチングする。図2に示す装置では、RF電極（陰極側電極）9を装置内に配設して一枚のシリコン基板1の表面をエッチングするが、図3に示す装置では、RF電極（陰極側電極）9を装置の外壁に配設して複数枚のシリコン基板1の表面を同時にエッチングするようにしている。

#### 【0031】

発生した活性種のうち、イオンがエッチングに作用する効果を大きくした方法を一般に反応性イオンエッチング法と呼んでいる。類似する方法にプラズマエッチングなどがあるが、プラズマ発生の原理は基本的に同じであり、エッチングされる基板1に作用する活性種の種類の分布をチャンバ構造、電極構造、あるいは発生周波数等により異なる分布に変化させているだけである。本発明はイオン効果の大きい反応性イオンエッチング法において特に有効であるが、原理的に反応性イオンエッチング法に限らず、他のプラズマエッチング法全般に対しても有効である。

#### 【0032】

本発明では、例えば三フッ化メタン（ $\text{CHF}_3$ ）を20 s c c m、塩素（ $\text{Cl}_2$ ）を50 s c c m、酸素（ $\text{O}_2$ ）を10 s c c m、六フッ化硫黄（ $\text{SF}_6$ ）を80 s c c m、さらにこれらに加えて $\text{H}_2\text{O}$ を1 s c c m流しながら、反応圧力7 Pa、プラズマを発生させるRFパワー500 Wで3分間程度エッチングする。これによりシリコン基板1の表面には表面凹凸構造2が形成される。エッチング中はシリコンがエッチングされて基本的には気化するが、一部は気化しきれずに分子同士が吸着してシリコン基板1の表面に残渣として残る。

#### 【0033】

また、ガス条件、反応圧力、RFパワーなどの表面凹凸構造2の形成条件をシ

リコンからなるエッチングの残渣が基板 1 の表面に残るような条件に設定すると、表面凹凸構造 2 を確実に形成することができる。ただし、その表面凹凸構造 2 のアスペクト比は条件によって最適化が必要である。逆に、シリコン基板 1 の表面に残渣が残らないような条件では表面凹凸構造 2 を形成することは困難である。

#### 【 0 0 3 4 】

本発明では、シリコン基板 1 と陽極側電極との間に、障害物 1 5 を配設する。このようにシリコン基板 1 を障害物 1 5 で覆蓋してエッチングすることで残渣の形成を促進させ、これに伴って表面凹凸構造 2 の形成を促進させることができる。

#### 【 0 0 3 5 】

図 4 は障害物を拡大して示す図である。図 4 において、1 はエッチングされるシリコン基板、9 は R F 電極（陰極側電極）、1 5 は障害物、1 7 は側壁、1 8 はチャンバ壁（陽極側電極）、1 9 は開口部、2 0 は絶縁体を示す。R F 電極（陰極側電極）9 上には、被エッチング体であるシリコン基板 1 が載置されている。アースに接続されたチャンバ壁 1 8 は陽極側電極となる。側壁 1 7 によって支えられた障害物 1 5 には、開口部 1 9 が多数形成されている。この開口部 1 9 でガスおよびプラズマが透過される。この開口部 1 9 の開口パターンは特に問わない。ただし、開口していない面積の大きい部分があるとエッチングムラが発生する。

#### 【 0 0 3 6 】

障害物 1 5 の実施形態を図 5 ～図 7 を用いてさらに詳しく説明する。図 5 において、1 6 は棒状部材、1 7 は側壁を示す。障害物 1 5 は棒状部材 1 6 によって略平板状に構成されその隙間が開口部 1 9 となってガスおよびプラズマを透過させる。また棒状部材 1 6 自体に穴をあけることによって開口部を設けることも可能である。

#### 【 0 0 3 7 】

この障害物 1 5 は図 6 のようにメッシュ構造にしても構わない。これにより 1 つずつの開口部 1 9 の面積を小さくすることができ、エッチングムラの発生を低

減することができるとともに、棒状部材 1 6 の太さを細くしたり、弱い材質の材料を用いたとしても強度を確保することができる。また図 7 に示すように積層構造にすることも可能である。さらに、これらの構成部材お複数組み合わせたものであってもよい。

## 【 0 0 3 8 】

この障害物 1 5 の材質はとくに問わない。アルミ系材質、ガラス系材質のどちらでも使用可能である。加工の容易さという面では金属が好ましいが、ステンレス系の材質などではシリコンのエッチングに用いるガスに曝されると腐食するためにシリコンをエッチングする際には不適である。一方、エッチング中はプラズマに曝されるために発熱する。この温度は条件によって大幅に変わるが、プラズマ中に温度が上昇して表面凹凸構造 2 の形成が一旦終了すれば大気中でシリコン基板 1 を取り出すといった工程となるため、温度の上下動に耐える材質が好ましい。そのため、高温のプラズマに曝される場合にはガラス系材質が望ましい。また、大面積になる場合にはガラス系材質では破損しやすいために取り扱いが困難となる。このような場合にはアルミ系の材質が適している。このように条件によって好ましい材質を選択することができる。また複数の材質を組み合わせることも可能である。例えば図 6 のようなメッシュ構造の場合、加工のしにくい例えばガラス系の材質でメッシュの縦方向をまっすぐに形成し、加工のしやすい例えばアルミ系の材質やテフロン（R）などの樹脂系の材料を横方向に編み込むようにして構成することもできる。図 7 のような構造の場合、下層はアルミ系の材質、上層はガラス系の材質にすることも可能である。

## 【 0 0 3 9 】

また棒状部材 1 6 の形状も問わない。例えば図 5 ～図 7 に示すように円柱状にしても構わないし、角柱形状としてもよい。さらに棒状部材をシート部材に置き換えれば、障害物の厚みが薄くなり、エッチングチャンバーの容積を小さくできる。また平板に近くなるためエッチング中の異常放電が発生しにくくなる。さらに、棒状部材 1 6 をワイヤー状の細いものにすれば、加工しやすく、重量の軽量化もはかれるのでさらによい。

## 【 0 0 4 0 】

ガスやプラズマを透過しない材質で障害物 1 5 を構成する場合、開口部 1 9 の開口率は 5 ～ 4 0 % にするのが望ましい。開口部 1 9 の開口率が 5 % 未満であるとシリコンのエッチングに必要なガスの供給が不十分となり、逆に残渣の形成速度が遅くなるため、表面凹凸構造 2 の形成が遅くなる。また、開口部 1 9 の開口率が 4 0 % を越えると、エッチング時に生成するシリコン化合物が揮発する際にシリコン基板 1 と障害物 1 5 の内部に閉じこめる効果が弱くなり、残渣の形成の促進効果が少なくなる。

## 【 0 0 4 1 】

障害物 1 5 は例えばテフロン ( R ) シートやアルミ箔などといったシートやフィルムで構成することも可能である。ガスやプラズマを透過する材質であれば、開口部 1 9 を形成しなくてもよい。

## 【 0 0 4 2 】

障害物 1 5 とシリコン基板 1 とは上述したエッチングを用いてシリコン基板をエッチングする場合、 5 m m から 3 0 m m の間隔を保持してエッチングを行うことが望ましい。このようにすることでエッチングするときに生成するシリコン化合物がシリコン基板 1 と障害物 1 5 の内部に閉じこめられる効果が生じ、シリコンを主成分とする残渣がシリコン基板 1 上に容易に生成しやすくなり、残渣の形成が促進されると同時に、表面凹凸構造 2 の形成を促進することができる。この障害物 1 5 とシリコン基板 1 との間隔が 5 m m 未満では表面凹凸構造 2 を形成するときに障害物 1 5 の開口部 1 9 がシリコン基板 1 の表面に模様として転写されてムラとなる。また、 3 0 m m を越えると残渣を早く形成して表面凹凸構造 2 の形成を促進する効果が少なくなる。

## 【 0 0 4 3 】

障害物 1 5 とシリコン基板 2 との距離を保持するための方法は、特に問わない。例えば図 4 から図 7 のように側壁 1 7 を設けることで間隔を保持する方法が簡単である。障害物 1 5 の厚みは特に問わない。強度と材料コスト、及びエッチング条件の関係により自由に設定することができる。

## 【 0 0 4 4 】

本発明は主に表面凹凸構造 2 を形成するために必要なエッチングのマスクとな

る残渣の発生を促進させることにより、表面凹凸構造 2 の形成速度を向上させることが目的であるが、シリコン基板 1 への表面凹凸構造 2 の形成が面内で均一になるという副次的な大きな効果がある。これは特に大面積の場合に有効である。

#### 【 0 0 4 5 】

ここまでエッチングされる基板としてバルク型シリコン太陽電池を例にとり説明を行ってきたが、これに限定されるものではない。エッチングされる基板はシリコンに限らず、ガラス、金属、プラスチック、樹脂のうちのいずれでもよく、例えば薄膜太陽電池の製造装置としても有効である。

#### 【 0 0 4 6 】

##### 【発明の効果】

以上のように、本発明による基板のエッチング装置では、陽極側電極に対向して設けた陰極側電極上に基板を載置して、この基板の表面を粗面状にするエッチング装置において、上記基板と陽極側電極の間に、棒状部材やメッシュ構造の障害物を設置したことから、プラズマエッチングを行うと、従来に比較して基板表面の凹凸構造形成を大幅に効率よく行うことができるようになる。そのため、高効率の太陽電池などに必要な基板の表面の微細な凹凸構造を高タクト、低コストで形成することが可能となる。

#### 【 0 0 4 7 】

また、本発明によるエッチング方法では、基板と陽極側電極との間に、棒状部材やメッシュ構造部材によって構成される略平板状の障害物を設置して上記基板を反応性イオンエッチング法で粗面状にすることから、従来に比較して基板表面の凹凸構造形成を大幅に効率よく行うことができるようになり、高効率の太陽電池などに必要な基板の表面の微細な凹凸構造を高タクト、低コストで形成することが可能となる。

##### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

本発明に係るエッチング装置で形成されるバルク型シリコン太陽電池を示す図である。

##### 【図 2】

本発明に係るエッチング装置の一例を示す図である。

【図 3】

本発明に係るエッチング装置の他の例を示す図である。

【図 4】

本発明に係るエッチング装置の障害物の一例を示す図である。

【図 5】

本発明に係るエッチング装置に用いる障害物の他の一例を示す図である。

【図 6】

本発明に係るエッチング装置に用いる障害物の他の一例を示す図である。

【図 7】

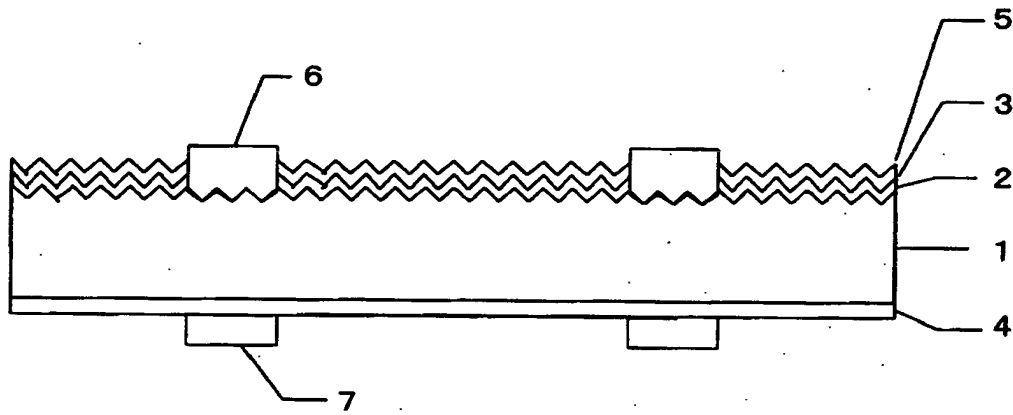
本発明に係るエッチング装置に用いる障害物の他の一例を示す図である。

【符号の説明】

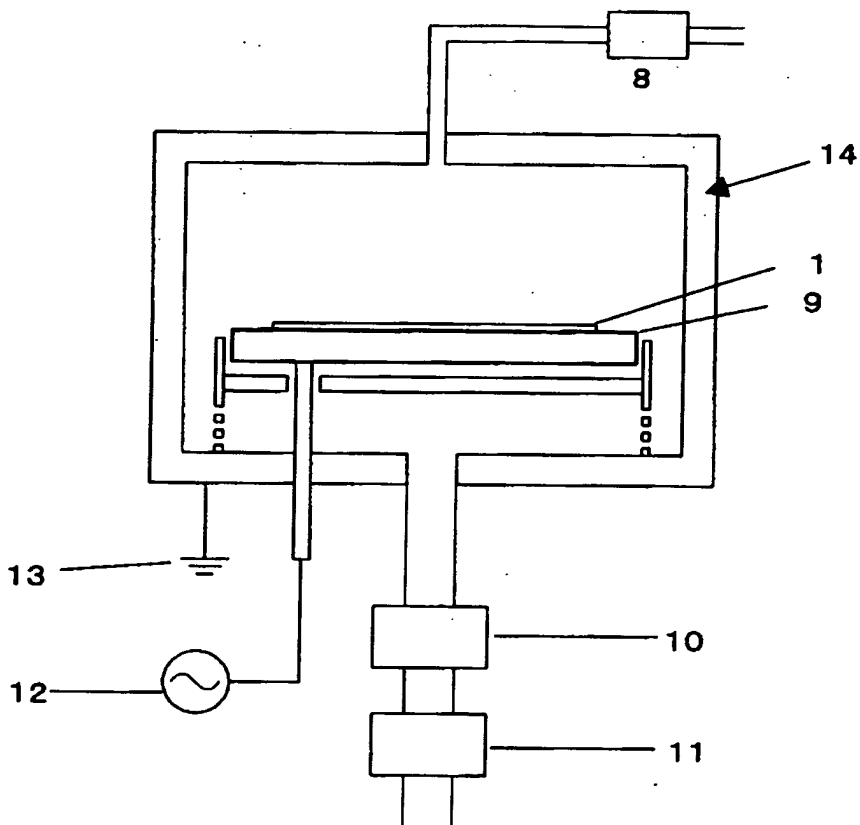
1 ; 基板、 9 ; 陰極側電極 ( R F 電極 ) 、 1 5 ; 障害物、 1 6 ; 棒状部材、 1 8 ; 陽極側電極 ( チャンバ壁 ) 、 1 9 ; 開口部

【書類名】 図面

【図 1】

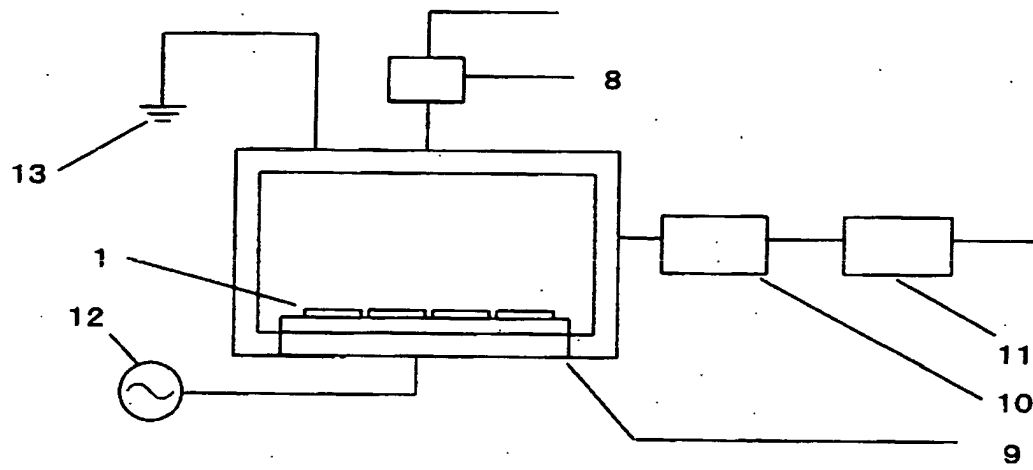


【図 2】

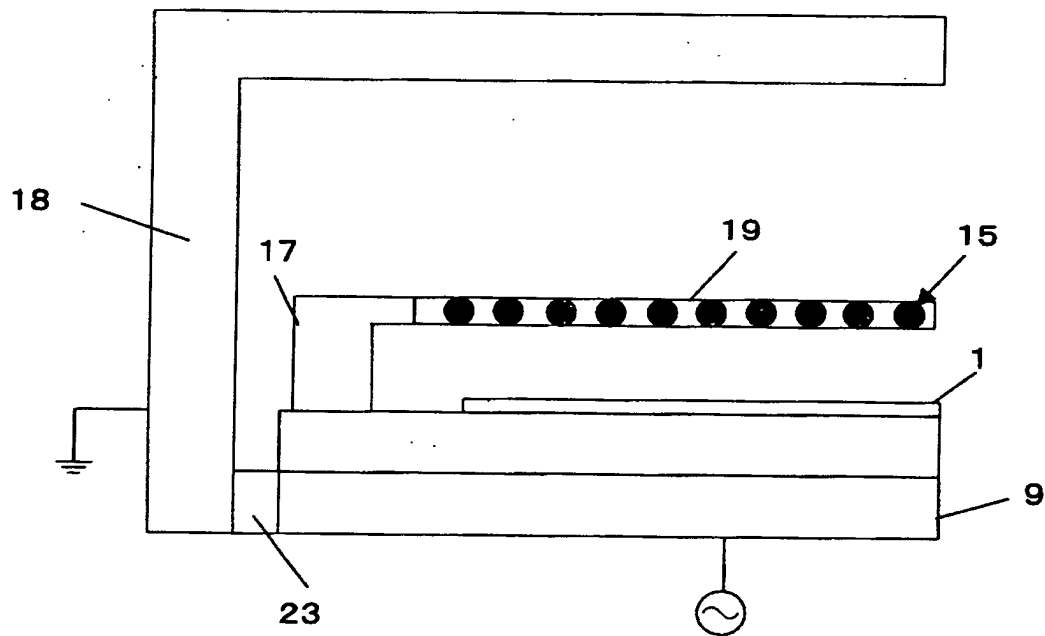




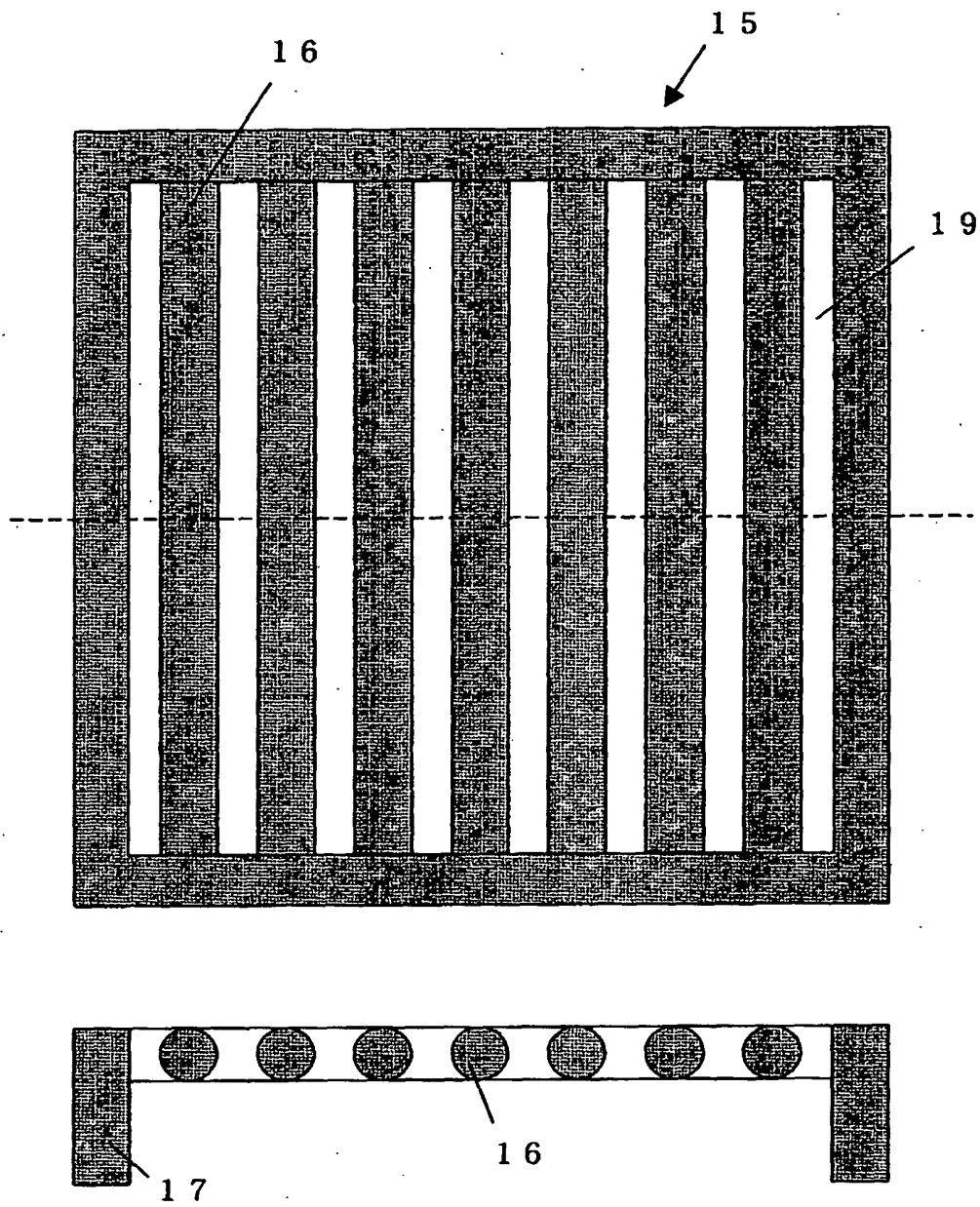
【図 3】



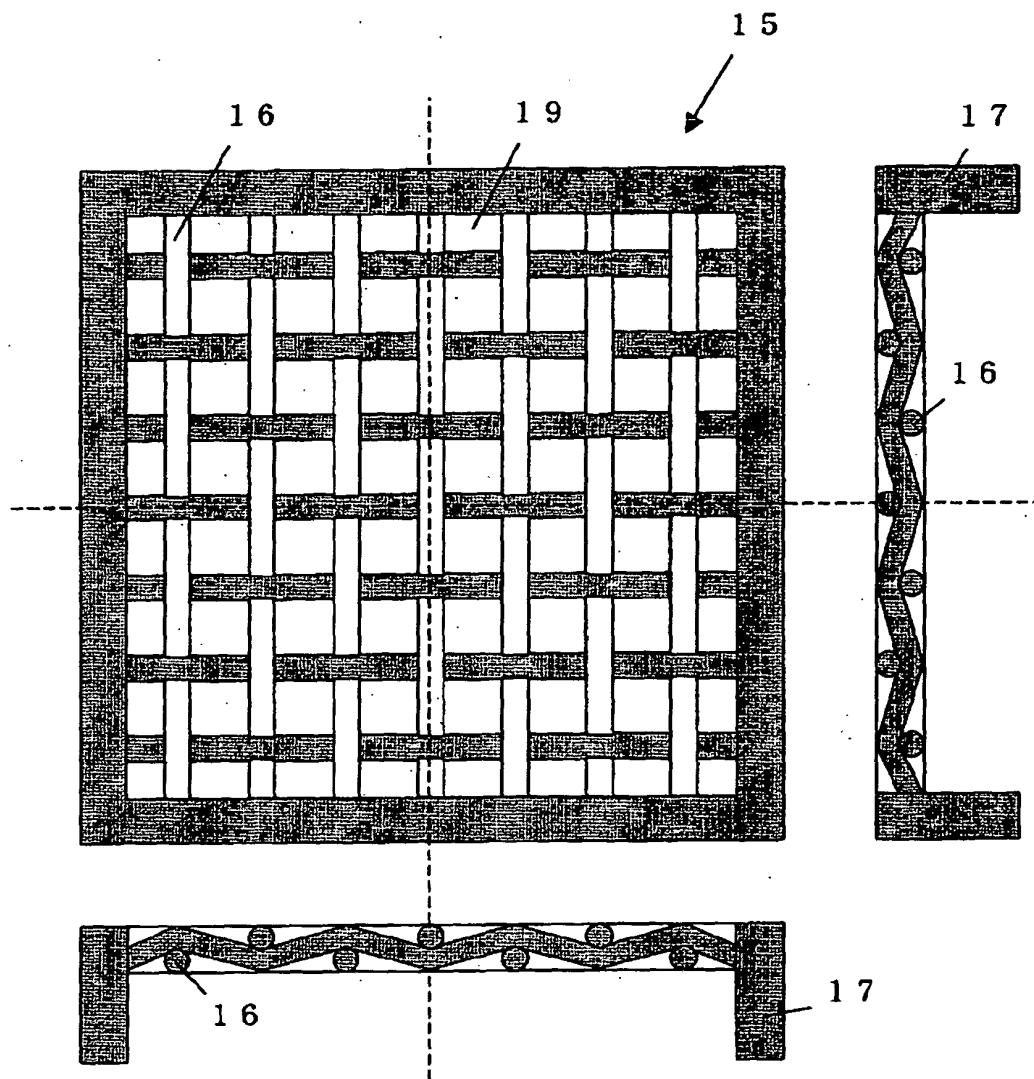
【図 4】



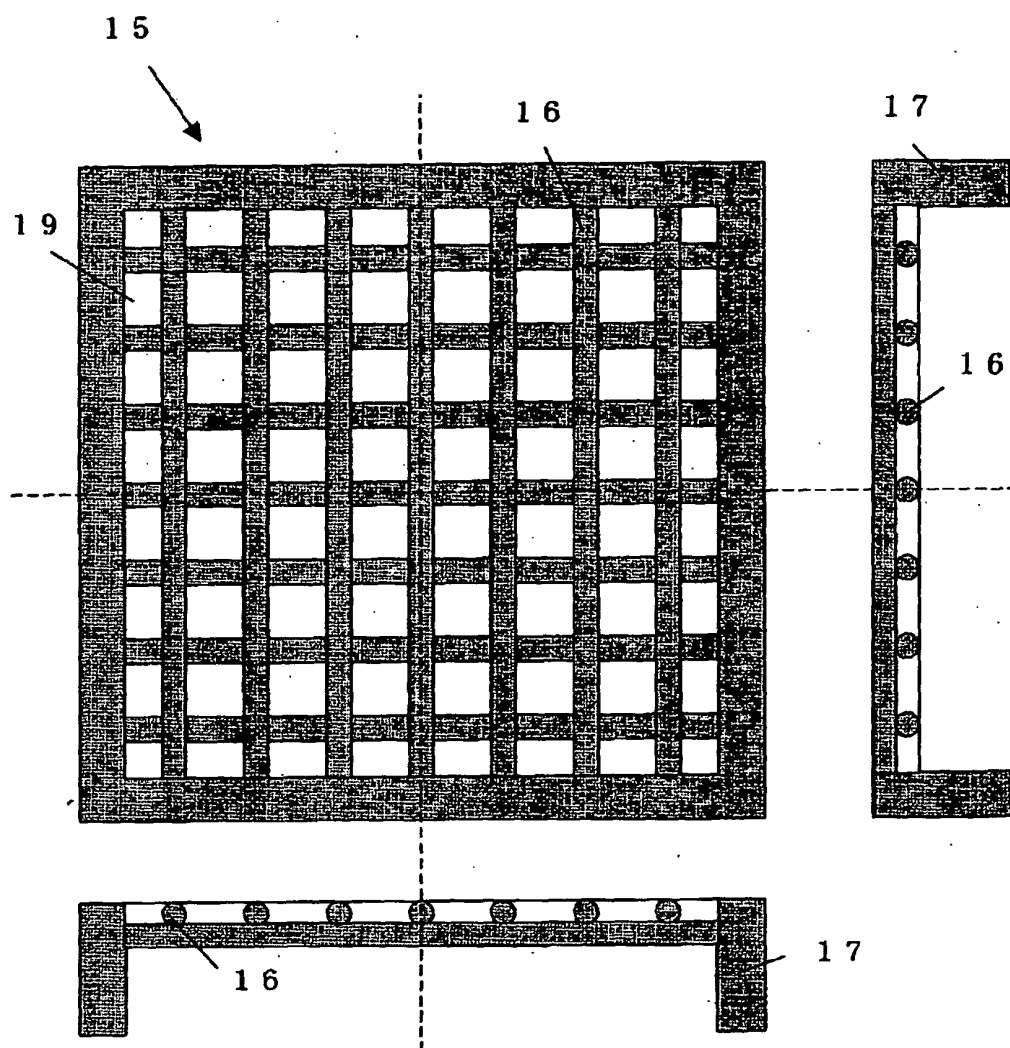
【図 5】



【図6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板、特に太陽電池に用いられる基板表面の凹凸形成を効率よく、高タクトで行うエッチング方法を提供する。

【解決手段】 陽極側電極 1 8 に対向して設けた陰極側電極 9 上に基板 1 を載置して、この基板 1 の表面を粗面状にするエッチング装置であって、上記基板 1 と陽極側電極 1 8 との間に、棒状部材やメッシュ構造の障害物 1 5 を設置してプラズマエッチングを行う。

【選択図】 図 4

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-311820	
受付番号	50201614985	
書類名	特許願	
担当官	第五担当上席	0094
作成日	平成14年10月28日	

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年10月25日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006633]

1. 変更年月日 1998年 8月21日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
氏 名 京セラ株式会社